

PNPエピタキシャル形シリコントランジスタ
低周波電力増幅用

PNP Silicon Epitaxial Transistor
Audio Frequency Power Amplifier

- オーディオアンプ等のドライバ段に最適です。
- 2SD571とコンプリメンタリで使用できます。
- 小形で P_T が大きく高耐圧である。

$$P_T = 1.0W, V_{CE0} = -50V$$

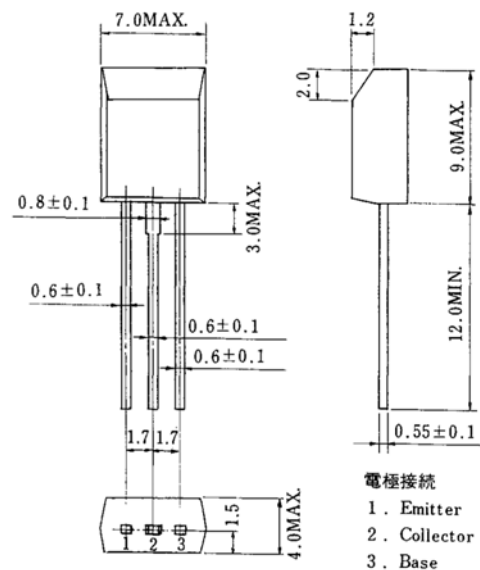
絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

項目	略号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-50	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5.0	V
コレクタ電流(直流)	$I_{C(DC)}$	-0.7	A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	-1.0	A
全損失	P_T	1.0	W
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ C$

* $PW \leq 10ms$, duty cycle $\leq 50\%$

外形図 / PACKAGE DIMENSIONS *

(Unit: mm)



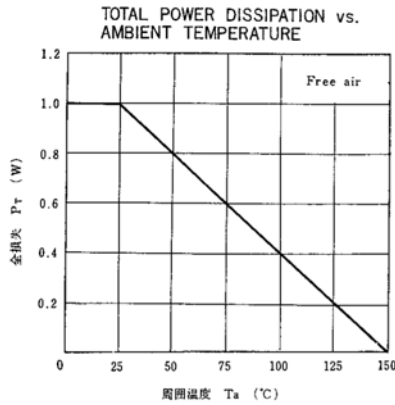
電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ C$)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -60V, I_E = 0$			-100	nA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5.0V, I_C = 0$			-100	nA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = -1.0V, I_C = -0.1A$ *	90	200	400	
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE} = -1.0V, I_C = -0.5A$ *	50	120		
直流ベース電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -6.0V, I_C = -10mA$ *	-600	-630	-700	mV
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -0.5A, I_B = -50mA$ *		-0.16	-0.35	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -0.5A, I_B = -50mA$ *		-0.90	-1.2	V
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB} = -6.0V, I_E = 0, f = 1.0MHz$		25		pF
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = -6.0V, I_E = 10mA$		120		MHz

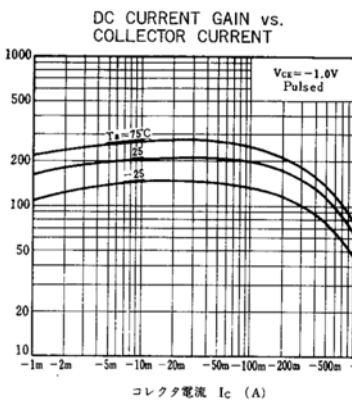
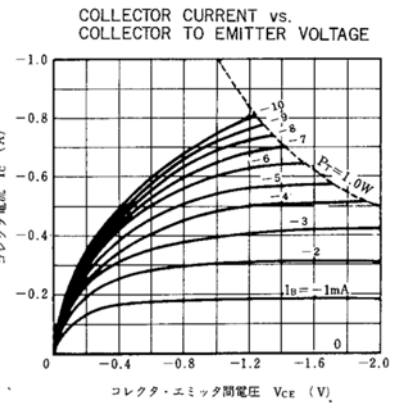
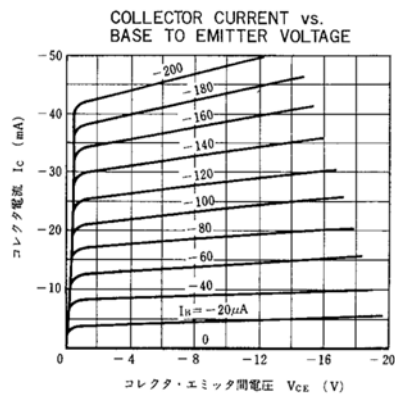
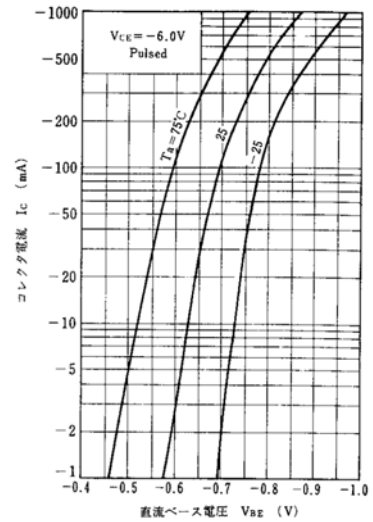
* パルス測定 $PW \leq 350\mu s$, duty cycle $\leq 2\%$ / Pulsed

h_{FE1} 区分★ / h_{FE1} Classification MA: 90~180 LA: 135~270 KA: 200~400

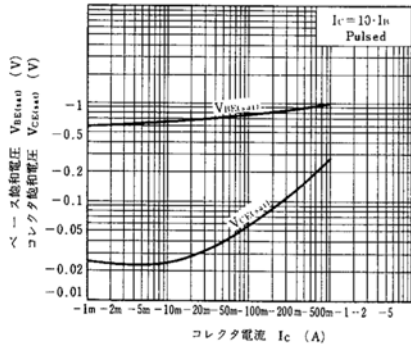
特性曲線 / TYPICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)



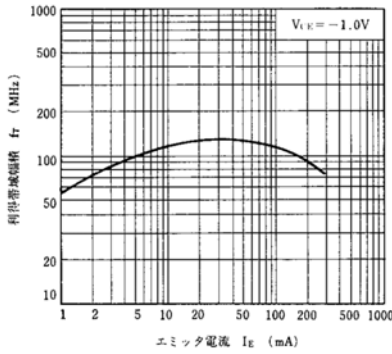
COLLECTOR CURRENT vs. BASE TO EMITTER VOLTAGE



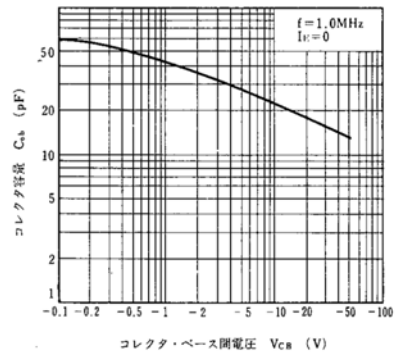
BASE AND COLLECTOR SATURATION VOLTAGE vs. COLLECTOR CURRENT



GAIN BANDWIDTH PRODUCT vs. EMITTER CURRENT



OUTPUT CAPACITANCE vs. COLLECTOR TO BASE VOLTAGE



NEC 日本電気株式会社

本支店 東京 東京都港区芝五丁目3番1号(日本電気本社ビル) 千108 電話 東京 (03)454-1111(大代)

札幌営業所 札幌市南一条西三丁目1番1号(住友生命札幌ビル) 千440 電話 札幌 (011)231-0163(代)